

# FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

Examen Parcial (2015-2016)

Apellidos, Nombre:

Compañía:

Sección AGM:

Grupo CUD:

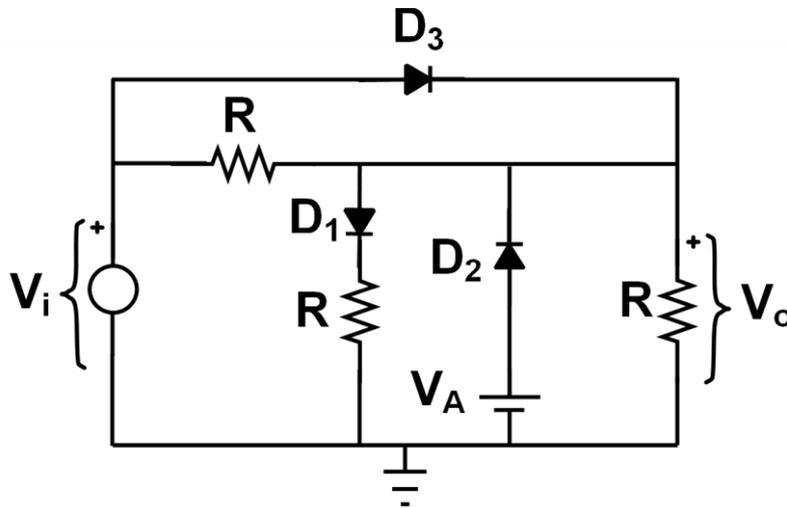
Fecha: 25/11/2015

- Rellene sus datos personales
- Esta hoja será grapada a los folios con las soluciones
- Comience cada ejercicio en cara nueva de folio
- Compruebe que tiene todas las cuestiones y ejercicios resueltos
- El examen deberá ser escrito a bolígrafo
- No usar bolígrafo rojo ni Tipp-Ex
- Se puede utilizar calculadora pero debe ser NO programable

Ejercicio 1	Cuestión 1	Ejercicio 2
/ 3	/ 2	/ 5
NOTA FINAL		

**EJERCICIO 1 (3 puntos)**

Dado el siguiente circuito basado en dos diodos y un diodo LED ( $D_3$ ).



$$V_A = 1 \text{ V}, R = 1 \text{ k}\Omega$$

- Comprobar que los tres diodos pueden estar en corte simultáneamente.
- Calcule el valor del voltaje  $V_0$  para una  $V_i$  que varía entre  $(-\infty, \infty)$ .

Suponga que la tensión umbral de los diodos es  $V_\gamma = 0.6 \text{ V}$  y la tensión umbral del LED es  $V_\gamma = 2.5 \text{ V}$ .

**CUESTIÓN 1 (2 puntos)**

Dos bloques de material semiconductor basado en Germanio a temperatura  $290 \text{ K}$  se dopan con la misma concentración de impurezas  $N_x = 7 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ , el bloque 1 con donadoras y el bloque 2 con aceptadoras.

- Calcular la concentración de portadores y el nivel de Fermi en cada bloque.
- ¿Qué material debemos iluminar para que ambos bloques tengan la misma conductividad? Justifique la respuesta.
- Calcular la concentración de portadores del material iluminado una vez que ha conseguido la misma conductividad que el otro bloque.
- Mencione otro motivo por el cual, sin variar la concentración de impurezas de los materiales, ambos bloques pueden tener la misma conductividad y no nula.

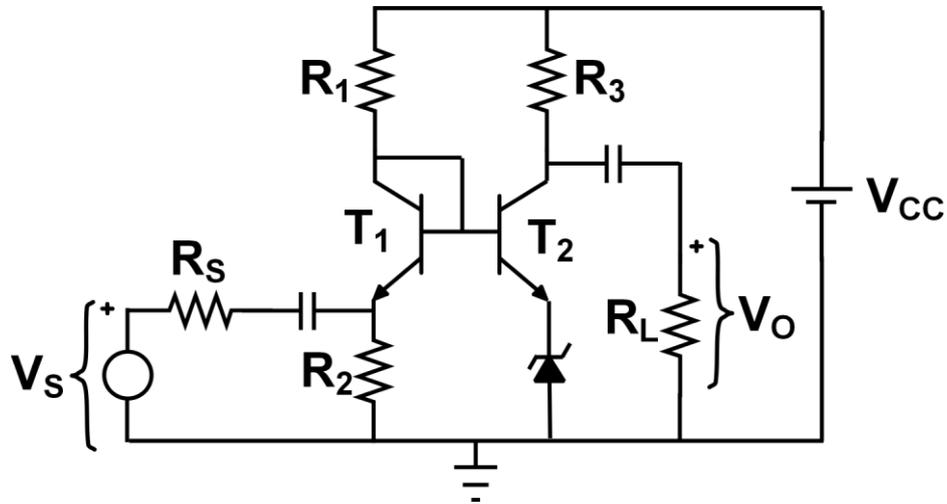
Datos:

$$N_C = 1.02 \cdot 10^{19} \text{ cm}^{-3}, N_V = 5.64 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}, E_g = 0.67 \text{ eV}$$

$$\mu_n = 3900 \text{ cm}^2/(\text{Vs}), \mu_p = 1820 \text{ cm}^2/(\text{Vs}), q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}, k = 86.2 \cdot 10^{-6} \text{ eV/K}$$

**EJERCICIO 2 (5 puntos)**

Sea el siguiente circuito basado en dos transistores NPN y un diodo zener donde todos los condensadores son de desacoplo.



$V_{CC} = 15\text{ V}$ ,  $V_S$  fuente de tensión alterna

$R_2 = 800\ \Omega$ ,  $R_3 = 1\ \text{k}\Omega$ ,  $R_S = 50\ \Omega$ ,  $R_L = 3\ \text{k}\Omega$

NPN:  $V_{BE} = 0.6\ \text{V}$  si la unión BE está en directa,  $\beta = 200$

Zener:  $V_Z = 0.7\ \text{V}$ , intensidad máxima en directa  $100\ \text{mA}$ , potencia máxima  $600\ \text{mW}$ , intensidad de ruptura mínima  $3\ \text{mA}$

- La medida experimental del voltaje que cae en las resistencias  $R_2$  y  $R_3$  es  $5,6\ \text{V}$  y  $8\ \text{V}$ , respectivamente. Calcular el punto de polarización de ambos transistores, el valor de la resistencia  $R_1$  y el valor de la tensión en ruptura del diodo zener. Comprobar que el zener se encuentra entre los límites permitidos.
- Representar el modelo de pequeña señal del circuito con y sin efecto Early.

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \quad r_o = \frac{V_A}{I_{CQ}} \quad V_T = 25.8\text{mV}$$

- Obtener la ganancia en tensión ( $A = V_0/V_S$ ) máxima sin efecto Early.
- Calcule, bajo las condiciones de ganancia máxima y sin efecto Early, la amplitud máxima de la señal  $V_S$  para la cual se alcanza el límite de aplicación del modelo de pequeña señal, definido por:

$$v_{be} < 10\text{mV}$$

- Calcule la impedancia de salida con efecto Early ( $V_A = 18\ \text{V}$ ).

# EJERCICIO 1

a) Suponemos todos los diodos off

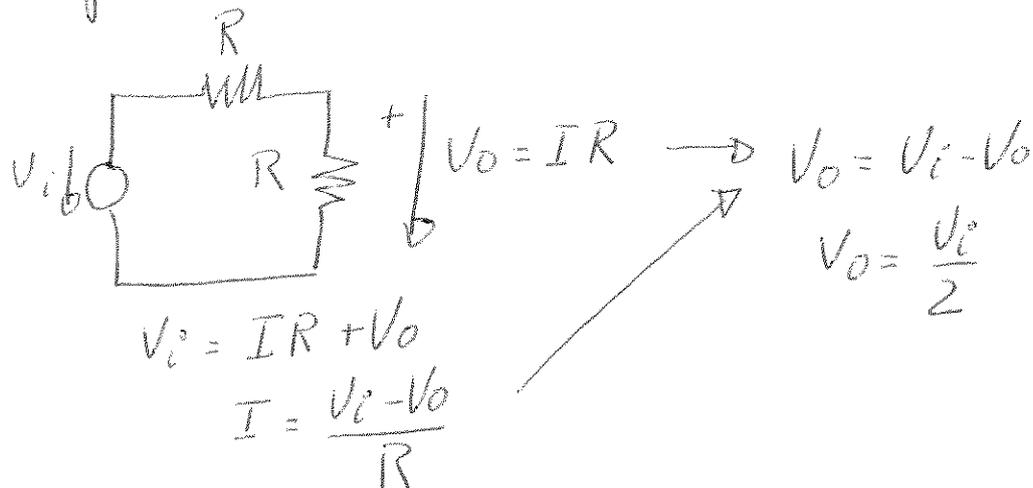
Limites de conducción en la rama.

$$D_1 \quad \left. \begin{array}{l} V_0 = V_{D_1} + IR \\ \text{Si } V_{D_1} < V_{\gamma} \Rightarrow I = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} V_{D_1} = V_0 < V_{\gamma} \quad D_1 \text{ off} \\ V_0 \geq V_{\gamma} \quad D_1 \text{ on} \end{array}$$

$$D_2 \quad \left. \begin{array}{l} V_A = V_{D_2} + V_0 \\ \text{Si } V_{D_2} < V_{\gamma} \Rightarrow D_2 \text{ off} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} V_{D_2} = V_A - V_0 < V_{\gamma} \quad D_2 \text{ off} \\ V_A - V_0 \geq V_{\gamma} \quad D_2 \text{ on} \end{array}$$

$$D_3 \quad \left. \begin{array}{l} V_i = V_{D_3} + V_0 \\ \text{Si } V_{D_3} < V_{\gamma_2} \Rightarrow D_3 \text{ off} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} V_{D_3} = V_i - V_0 < V_{\gamma_2} \quad D_3 \text{ off} \\ V_i - V_0 \geq V_{\gamma_2} \quad D_3 \text{ on} \end{array}$$

Suponemos todos los diodos off

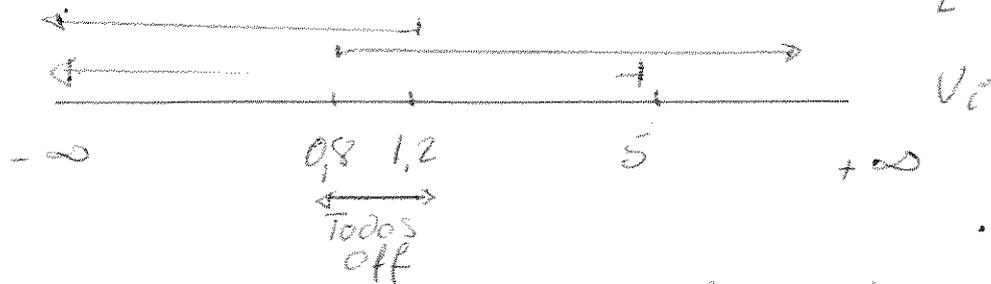


Comprobamos:

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } D_1 \text{ off} \Rightarrow V_o < V_{\gamma} \\ \text{como } V_o = \frac{V_i}{2} \end{array} \right] \Rightarrow V_i < 2V_{\gamma} = 1,2V \\ D_1 \text{ off}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } D_2 \text{ off} \Rightarrow V_A - V_o < V_{\gamma} \\ \text{como } V_o = \frac{V_i}{2} \end{array} \right] \Rightarrow V_A - \frac{V_i}{2} < V_{\gamma} \\ V_i > 2(V_A - V_{\gamma}) = 0,8V \\ D_2 \text{ off}$$

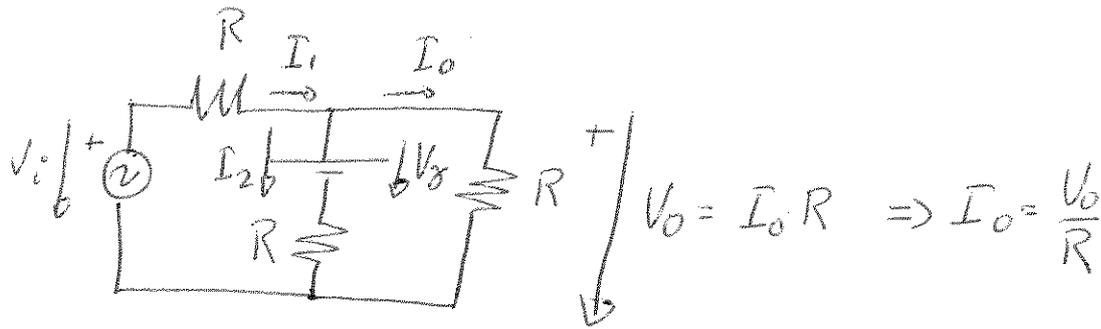
$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } D_3 \text{ off} \Rightarrow V_i - V_o < V_{\gamma_L} \\ \text{como } V_o = \frac{V_i}{2} \end{array} \right] \Rightarrow V_i - \frac{V_i}{2} < V_{\gamma_L} \\ V_i < 2V_{\gamma_L} = 5V$$



Cuando  $0,8V < V_i < 1,2V$  todos los diodos estarı́n en corte.

b) Para  $0,8V < V_i < 1,2V \Rightarrow V_o = \frac{V_i}{2}$

Si  $V_i \geq 1,2V$   $D_1$  entra en conducción. Suponemos  $D_2, D_3$  en corte.



$$I_1 = I_2 + I_o$$

$$V_i = I_1 R + V_o \Rightarrow I_1 = \frac{V_i - V_o}{R}$$

$$V_o = V_\gamma + I_2 R \Rightarrow I_2 = \frac{V_o - V_\gamma}{R}$$

Como  $I_1 = I_2 + I_o \Rightarrow \frac{V_i - V_o}{R} = \frac{V_o - V_\gamma}{R} + \frac{V_o}{R}$

$$V_o = \frac{V_i + V_\gamma}{3}$$

Comprobamos

Si  $D_2$  off  $\Rightarrow V_A - V_o < V_\gamma$   
 como  $V_o = \frac{V_i + V_\gamma}{3}$   $\Rightarrow V_A - \frac{V_i + V_\gamma}{3} < V_\gamma$

$$V_i > 3V_A - 4V_\gamma = 0,6V$$

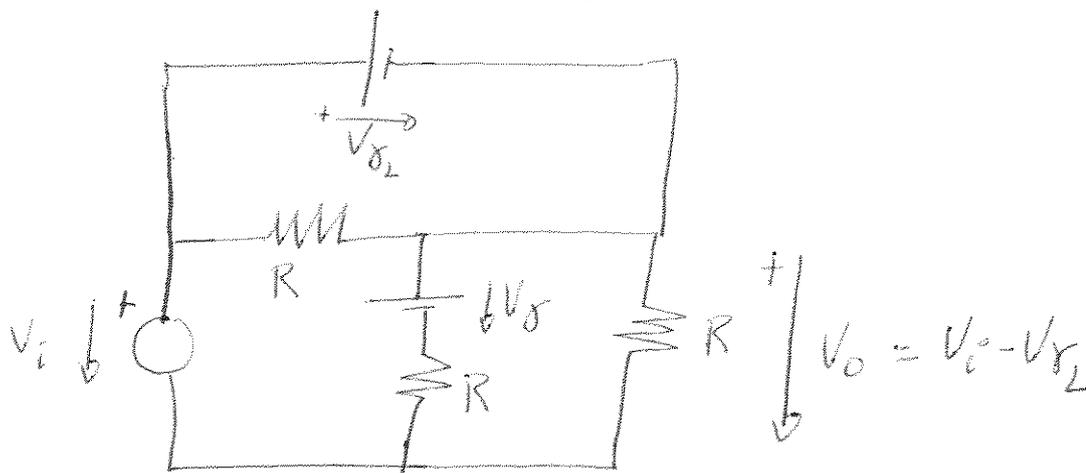
$V_i > 0,6V$  para todo el intervalo  $V_i \geq 1,2V$ , por lo que el diodo  $D_2$  está en corte en todo el intervalo.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } D_3 \text{ off } V_i - V_o < V_{D_2} \\ \text{como } V_o = \frac{V_i + V_D}{3} \end{array} \right] \Rightarrow V_i - \frac{V_i + V_D}{3} < V_{D_2}$$

$$V_i < \frac{3}{2} V_{D_2} + \frac{V_D}{2} = 4,05V$$

El diodo  $D_3$  entra en conducción, en el intervalo  $V_i \geq 1,2V$ , cuando  $V_i \geq 4,05V$

Si  $V_i \geq 4,05V$   $D_1$  y  $D_3$  on. Suponemos  $D_2$  off.



Comprobamos

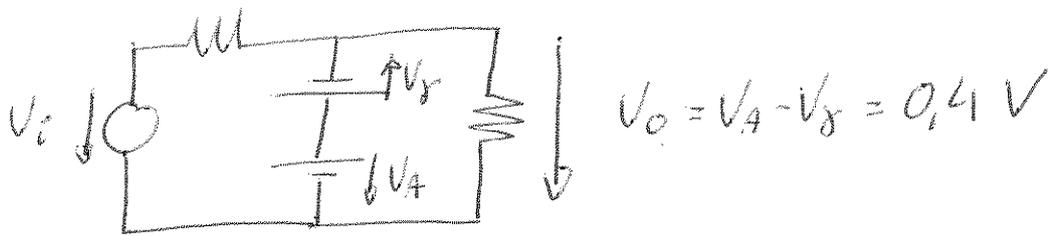
$$\left. \begin{array}{l} \text{Si } D_2 \text{ off } V_A - V_o < V_D \\ \text{como } V_o = V_i - V_{D_2} \end{array} \right] \Rightarrow V_A - V_i + V_{D_2} < V_D$$

$$V_i > V_A + V_{D_2} - V_D = 2,9$$

$V_i > 2,9$  en todo el intervalo <sup>OK</sup>

$V_i \geq 4,05$ , por lo que el  $D_2$  no entra en conducción en este intervalo.

Si  $V_i \leq 0,8V$  el  $D_2$  entra en conducción. Suponemos  $D_1$  y  $D_3$  en corte.



Comprobamos

Si  $D_1$  off  $V_o < V_D$  ]  $\Rightarrow 0,4 < 0,6 V$  ok.  
 Como  $V_o = 0,4V$  Para todo el intervalo  $D_1$  está en corte

Si  $D_3$  off  $V_i - V_o < V_{D2}$  ]  $\Rightarrow V_i - 0,4 < V_{D2}$   
 Como  $V_o = 0,4V$   $V_i < V_{D2} + 0,4 = 2,9V$   
 Para todo el intervalo  $D_3$  está en corte.

# CUESTION 1

$$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-\frac{E_g}{2kT}} \approx 1.15 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$$

a) Bloque 1:  $N_D = 7 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

Como  $N_D \gg n_i$   $\left\{ \begin{array}{l} n_0 \approx N_D = 7 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \\ p_0 \approx \frac{n_i^2}{N_D} = 1.88 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3} \end{array} \right.$

$$E_F = E_c + kT \ln \frac{n_0}{n_i} = 0.553 \text{ eV}$$

Bloque 2:  $N_A = 7 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

Como  $N_A \gg n_i$   $\left\{ \begin{array}{l} p_0 \approx N_A = 7 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \\ n_0 \approx \frac{n_i^2}{N_D} = 1.88 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3} \end{array} \right.$

$$E_F = E_c + kT \ln \frac{n_0}{n_i} = 0.117 \text{ eV}$$

b) Bloque 1:  $\sigma_1 \approx q \mu_n N_x$   $\left( \mu_n > \mu_p \rightarrow \sigma_1 > \sigma_2 \right)$

Bloque 2:  $\sigma_2 \approx q \mu_p N_x$

sin luz:  $\left\{ \begin{array}{l} n_0 \\ p_0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \sigma = q (\mu_n n_0 + \mu_p p_0) \end{array} \right.$

con luz:  $\left\{ \begin{array}{l} n = n_0 + x \\ p = p_0 + x \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \sigma' = q (\mu_n n + \mu_p p) \end{array} \right.$

con luz aumenta la conductividad  $\sigma' > \sigma$

Por lo tanto, iluminamos el bloque 2 para que  $\sigma_2' = \sigma_1$

c) Bloque 2 iluminado  $\left\{ \begin{array}{l} n = n_0 + x = \frac{n_i^2}{N_A} + x \approx x \\ p = p_0 + x = N_A + x \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} \sigma_2' = q \mu_n x + \mu_p (N_A + x) \end{array} \right.$

$$\sigma_2' = \sigma_1 \rightarrow \mu_n x + \mu_p (N_A + x) = \mu_n N_x \rightarrow$$

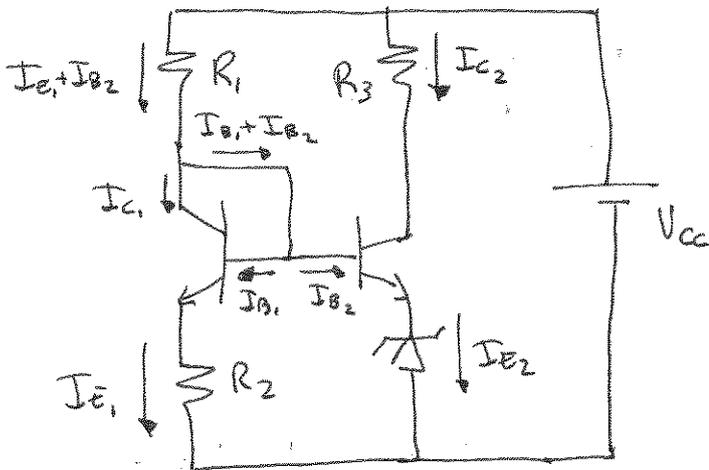
$$\rightarrow x = \frac{\mu_n N_x - \mu_p N_A}{\mu_n + \mu_p} = 2.55 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n \approx 2.55 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \\ p \approx 9.55 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3} \end{array} \right.$$

d) Aumentar la temperatura también provoca un aumento de conductividad. En materiales extrínsecos la conductividad es aprox. constante si  $N_x \gg n_i$  y tiende a incrementarse cuando no se cumple esa condición. Por lo tanto, habría que aumentar la  $T^\circ$  del bloque 2.

# EJERCICIO 2

a) Circuito en DC



$$V_{R2} = 5.6V \rightarrow I_{E1} = \frac{V_{R2}}{R2} = 7mA$$

$$V_{R3} = 8V \rightarrow I_{C2} = \frac{V_{R3}}{R3} = 8mA$$

Supongo activa para T1 y T2

$$I_{E1} \left\{ \begin{array}{l} I_{B1} = 34.8 \mu A \\ I_{C1} = 6.965 mA \end{array} \right. \quad I_{C2} \left\{ \begin{array}{l} I_{B2} = 40 \mu A \\ I_{E2} = 8.04 mA \end{array} \right.$$

Zener en ruptura porque  $I_{E2} > 0 \rightarrow V_{BE} + V_{R2} = V_{BE} + V_Z \rightarrow V_Z = 5.6V$

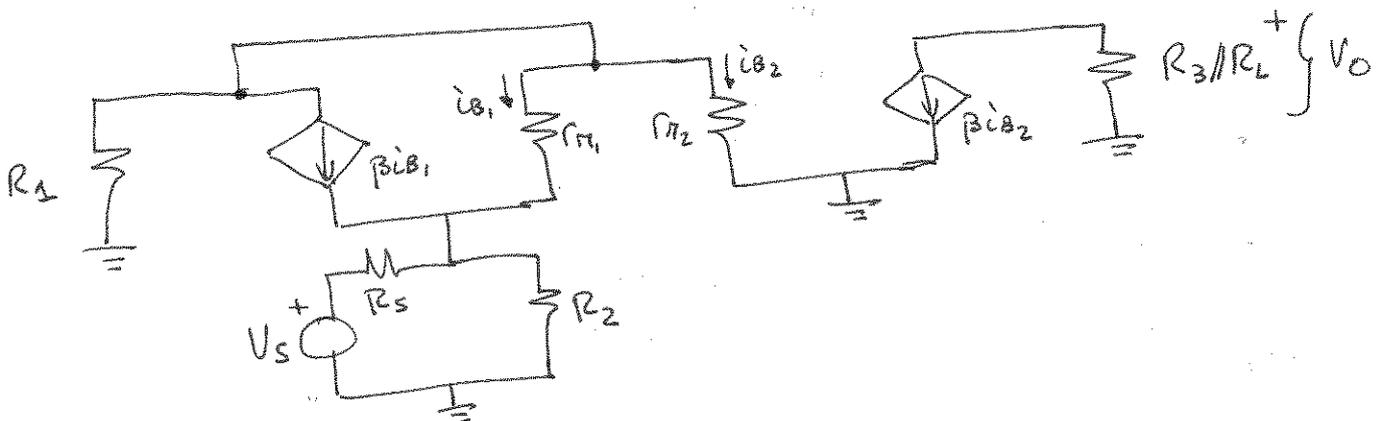
Malla para R1  $\rightarrow V_{CC} = R1(I_{E1} + I_{B2}) + V_{BE} + V_Z \rightarrow R1 = 1.25 K\Omega$

Malla CE1  $\rightarrow V_{CE1} = V_{BE} = 0.6V > 0.2V$  OK T1 ACTIVA

Malla CE2  $\rightarrow V_{CE2} = V_{CC} - V_{R3} - V_Z = 1.4V > 0.2V$  OK T2 ACTIVA

$$I_Z = I_{E2} = 8.04 mA \left\{ \begin{array}{l} > I_{Z,min} = 3mA \\ < I_{Z,max} = \frac{P_{max}}{V_Z} = 107.1 mA \end{array} \right.$$

b) sin efecto Early



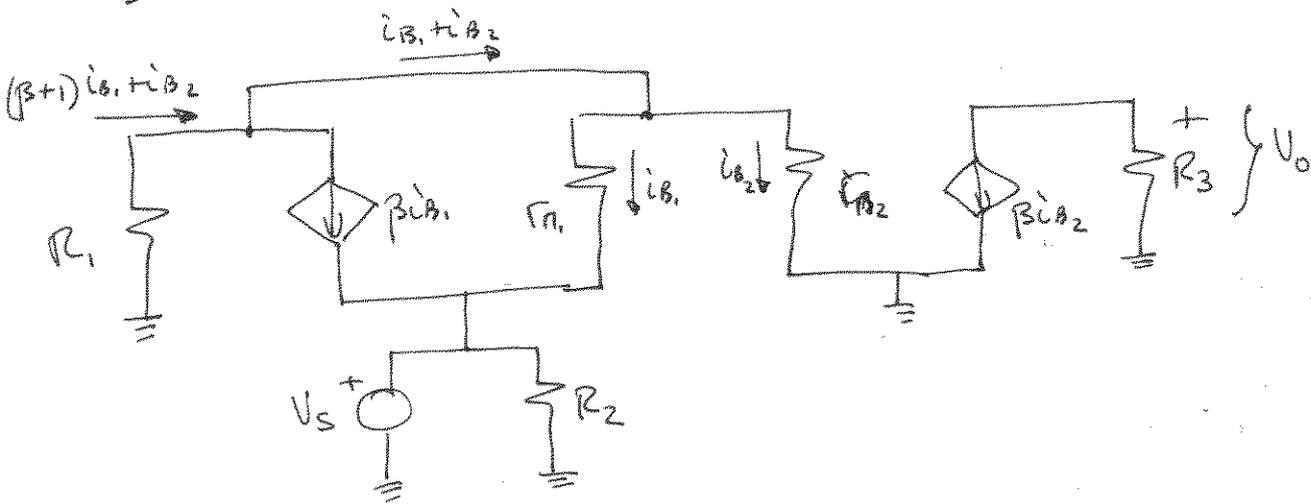
$$g_{m1} = 269.96 mA/V$$

$$r_{\pi 1} = 740.85 \Omega$$

$$g_{m2} = 310.08 mA/V$$

$$r_{\pi 2} = 645 \Omega$$

c) Ganancia máxima para  $R_S = 0$ ,  $R_L = \infty$



$$V_0 = -\beta i_{B2} R_3$$

$$\left[ (\beta+1) i_{B1} + i_{B2} \right] R_1 + i_{B2} r_{\pi 2} = 0 \rightarrow i_{B1} = \frac{-i_{B2} (R_1 + r_{\pi 2})}{(\beta+1) R_1} \quad *$$

$$V_S + i_{B1} r_{\pi 1} = i_{B2} r_{\pi 2} \rightarrow V_S = i_{B2} \left[ r_{\pi 2} + r_{\pi 1} \frac{(R_1 + r_{\pi 2})}{(\beta+1) R_1} \right] \quad **$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_S} = \frac{-\beta R_3}{r_{\pi 2} + r_{\pi 1} \frac{(R_1 + r_{\pi 2})}{(\beta+1) R_1}} = -307.4$$

$$d) \quad i_{B1} = \frac{-i_{B2} (R_1 + r_{\pi 2})}{(\beta+1) R_1} \rightarrow \frac{V_{be1}}{r_{\pi 1}} = \frac{-V_{be2} (R_1 + r_{\pi 2})}{(\beta+1) R_1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{V_{be1}}{V_{be2}} = \frac{-r_{\pi 1} (R_1 + r_{\pi 2})}{r_{\pi 2} (\beta+1) R_1} = -0.0087$$

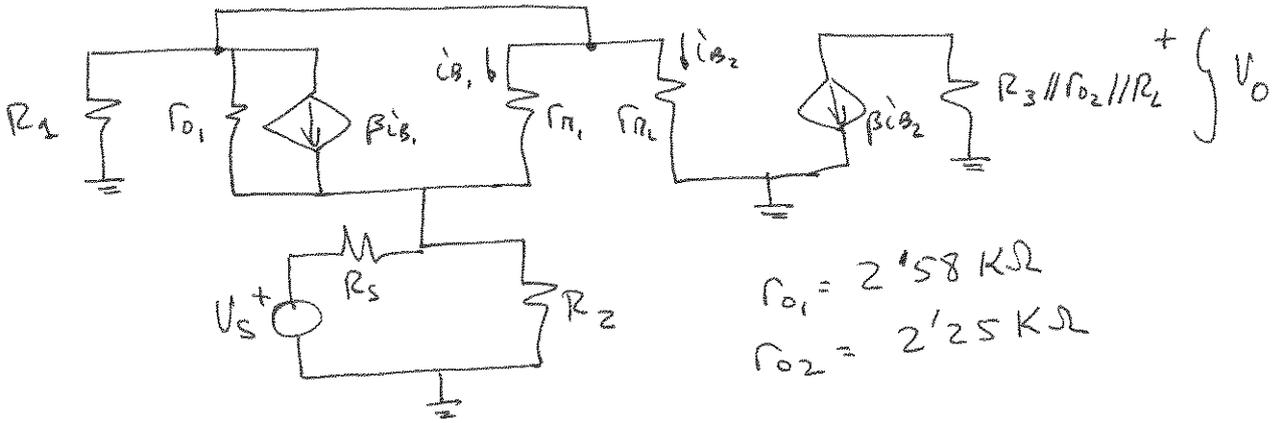
→ la amplitud de  $V_{be1} <$  la amplitud de  $V_{be2}$

→ impongo el límite a  $V_{be2}$ .

$$** \quad V_S = \frac{V_{be2}}{r_{\pi 2}} \left[ r_{\pi 2} + \frac{r_{\pi 1} (R_1 + r_{\pi 2})}{(\beta+1) R_1} \right]$$

$$\text{Si } V_{be2} < 10 \text{ mV} \rightarrow V_S < 10.087 \text{ mV}$$

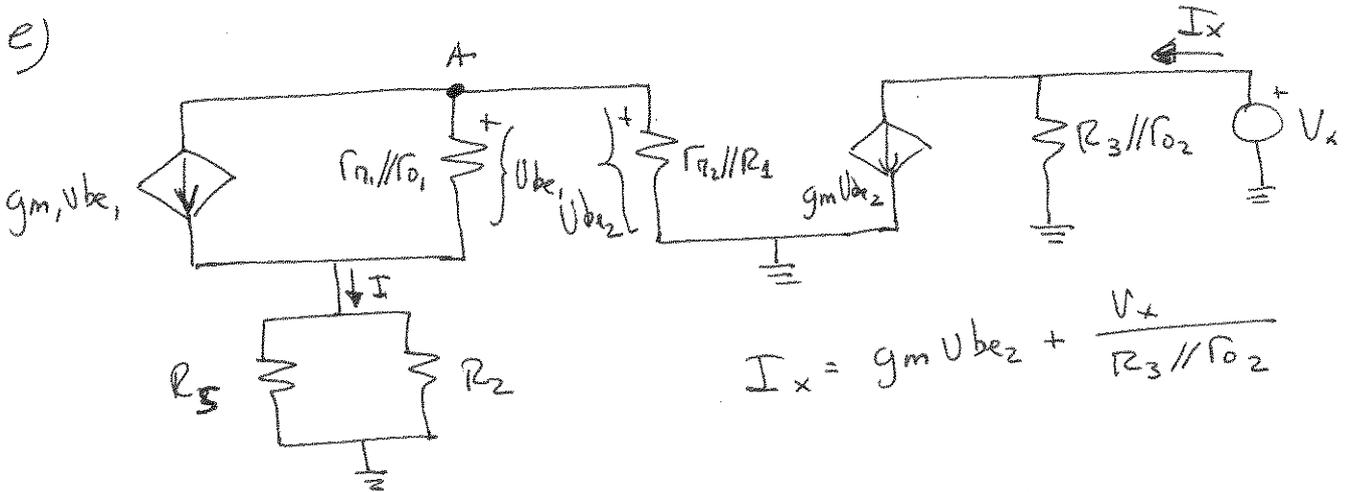
b) con efecto Early



$$r_{o1} = 2'58 \text{ K}\Omega$$

$$r_{o2} = 2'25 \text{ K}\Omega$$

e)



$$I_x = g_m U_{be2} + \frac{V_x}{R_3 // r_{o2}}$$

NUDO A

$$g_m U_{be1} + \frac{U_{be1}}{r_{e1} // r_{o1}} + \frac{U_{be2}}{r_{e2} // R_L} = 0 \quad \begin{matrix} \rightarrow U_{be1} = 0 \\ \downarrow U_{be2} = 0 \end{matrix}$$

MOLLA

$$U_{be1} + \left( g_m U_{be1} + \frac{U_{be1}}{r_{e1} // r_{o1}} \right) R_2 // R_s = U_{be2}$$

$$\Rightarrow I_x = \frac{V_x}{R_3 // r_{o2}} \rightarrow R_{out} = \frac{V_x}{I_x} = R_3 // r_{o2} = 692'3 \text{ }\Omega$$